



	<h2 style="color: red;">SI4808DY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4808DY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4808DY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 18578 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4808DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	18578 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 7.5A, 10V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 5.7A 1.1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.7A

SI4808DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4808DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4808DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4808DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4807DY-T1 SILICON SI4807DY-T1 SILICON</p>	 <p>SI4808DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC</p>	 <p>SI4807DY-T1-E3 VISHAY SI4807DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4810 SI SI4810 SI</p>
 <p>SI4808DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC</p>	 <p>SI4808DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC</p>	 <p>SI4804Y SI</p>	 <p>SI4804DY-T1-GE3 V SI4804DY-T1-GE3 V</p>

SI4808DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4808DY-T1-E3 Datenblatt	SI4808DY-T1-E3-Datenblätter	SI4808DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4808DY-T1-E3
SI4808DY-T1-E3 Electronic	SI4808DY-T1-E3-Komponenten	SI4808DY-T1-E3-Verteiler	SI4808DY-T1-E3-Bild	SI4808DY-T1-E3 Aktie	SI4808DY-T1-E3 Teil
SI4808DY-T1-E3 Preis	SI4808DY-T1-E3 Hersteller	SI4808DY-T1-E3 garantiert	SI4808DY-T1-E3 RFQ	SI4808DY-T1-E3 Inventar	SI4808DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited